PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-135763

(43) Date of publication of application: 23.06.1986

(51)Int.CI.

B41J 3/20

H01C 7/00

H01L 49/00

(21) Application number: **59-258055**

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC

IND CO LTD

(22)Date of filing:

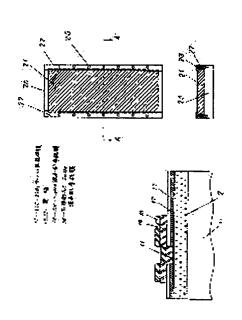
06.12.1984

(72)Inventor:

KURAMASU KEIZABURO HATTORI TAKAMICHI

KORECHIKA AKIHIRO

(54) THERMAL HEAD



(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of static electricity, by laminating a SiC-Si5 N4 blended abrasion resistance protective film having a metal added thereto to the surface contacted with special paper by using a SiC-Si3C4 blended abrasion resistant protective film.

CONSTITUTION: Blended protective films 14, 15 each having a thickness of about 3μ m are formed to a head substrate 1 having a TiC-SiO2 thermet film as a heat generating resistor film 1 and Cr-Cu2 films as electrodes 12, 13 by simultaneously sputtering both plates comprising SiC and Si5N4 as sputtering targets in argon gas containing 10% of hydrogen gas and 5% of nitrogen gas. Thereafter, the discharge of a target, wherein Ti is provided to the peripheral part of a Si3N4 plate, is started to perform the formation of films by three targets so as to adjust a total film thickness to about 5μ m. Furthermore, a

copper plate 20, a Si5N4 plate 21 and a Ti plate 22 for attaching targets are provided. The Ti plate 22 and the Ti screw pressing the Ti plate 22 are set to an areal ratio of about 5vol% or less in the blended film formed by the simultaneous sputtering of three targets.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 135763

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)6月23日

3/20 7/00 B 41 J H OI C H 01 L 49/00

F-8004-2C 111 8525-5E

6819-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

サーマルヘツド

20特 昭59-258055 願

昭59(1984)12月6日 ❷出 頭

⑫発 眀 者 勿発 明 者

増 敬三郎 部 服 孝 道 門真市大字門真1006番地 門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内

⑫発 眀 者 是 近 哲 広

門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内

勿出 顋 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

弁理士 中尾 ②代 理 敏男

外1名

明

1、発明の名称

サーマルヘッド

2、特許請求の範囲

絶縁性基板上に形成した抵抗体膜・給電用導体 膜および耐摩耗保護膜よりなる感熱記録用サーマ ルヘッドの前記耐摩耗保護膜を、炭化珪素化合物 と窓化珪素化合物よりなる膜と、炭化珪素化合物 と窒化珪素化合物および金属を混合してなる膜を 積層して構成したことを特徴とするサーマルヘッ ١ ٥

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は感熱記録用サーマルヘッドの耐摩耗保 護膜の改良に関する。感熱記録方式は保守の容易 **なハードコピーを得る方式として、各種の端末記** 録装置やファクシミリ等に利用されている。特に 近年は、熱転写記録方式による多色記録やフルカ ラー記録の開発も活発で、事務機器分野や家庭用 ブリンタとして期待されている。

従来の技術

一般に、サーマルヘッドは第5図に示す発熱体 部構造を有している。同図において、1はアルミ ナ基板、2はグレーメ層、3は発熱抵抗体膜、4 および5は2層構成電極で、4は下層電極で主と して密着層、5は上層電極で主導体層として働く。 なむ、下層電極4は用いない場合もある。6は発 熱抵抗体膜を酸化から防止するための酸化防止膜、 7は耐摩耗保護膜である。ととで、酸化防止膜6 は用いない場合もある。このサーマルヘッドはフ ァクシミリに多用されて大きく伸びてきたが、今 後はさらに各種のブリンタ等に増々多く用いられ るようになると予測されている。このためには、 より高速化・高信頼性および低コスト化が要求さ れており、駆動回路のIC化とともに発熱体材料 の開発が積極的に行われている。高速化と高信頼 性のサーマルヘッドを実現する上では、耐熱衝撃 性と耐摩耗性に優れた耐摩耗保護膜を開発すると とも重要である。この要請に対して、本発明者等 により特開昭59-111871号公報に示す新

規引取耗保証膜材料に関する発明が出願されている。この発明は、耐取耗保証膜として炭化珪素化合物の混合被膜を用いることで

な性を高めて耐燥値型性を改良するとともに、感 は紙を用いた印字時に生じていた電気化学的反応 による取耗を防止して耐取耗性を大きく改容した ものである。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、炭化珪宗化合物と窒化珪宗化合物(以降、各々をSiC、SisNaとする。)の混合被腹よりなる耐取耗保取膜は、ポリエステルの等の樹脂を保取膜は、ポリエステルの等の樹脂を保取にない。からないは、から、大きの配のなりな特殊紙での印字は今後のブリンタに多くのような特殊紙での印字は今後のブリンタに多くのような特殊紙にないても発色形態になっても発色形態になっても発色形態がでの記録率が要がされていた。

通常の発色形感無においても、下層の SIC-SI,N。混合耐磨耗保証膜が充分な何気絶縁性を有していることから、電気化学的反応による膨耗も生じない。さらに、金属を添加することで保む膜の
類性が向上し、耐熱衝容性が向上する。

突施例

以下に本発明を突施例に従って説明する。 〈実施例1〉

発無抵抗体膜としてT1C-S102サーメット膜、 配極としてCr-Gu 2 階膜よりなるヘッド基板上 に、以下のように耐壓耗保散膜をスパッタリング用のター がットとして、S1CかよびS13N、からなる板を それぞれ用いて、水気ガスを1 0 %、窓案ガスを 5 %含むアルゴンガス中で両ターゲット を同時を に スパッタリングして、約3 4 m の混合保 形 に た。この場合、S1CとS13N。 の混合比 に そ 々のターゲットに印加する (日)に 示すよりに S13N。板の周辺部にT1を設けたターゲット

前記 Si C-Si, N。混合併尿底保股膜の場合化特殊紙での記録寿命の低下は、耐尿耗保股膜の比抵抗が 10¹⁰~10¹⁵Q・四であり、このために特殊紙での印字記録時に原電気が発生し放電することにより破線が生じるものである。

この船電気による破線を防止する方法としては、 SiC-Si,N.混合耐線 低保証膜の特殊紙と接触 する面の比抵抗を小さくし船包気が帯電しないよ うにすることで防止できる。

問題点を解決するための手段

本発明はSIC-Si,N。混合耐壓純保設膜を用いて、特殊無と接触する面に金属を添加したSIC-Si,N。混合耐尿純保監膜を积局することにより降電気の発生を防止することを可能としたものである。

作用

の放電を開始して、3つのターゲットにより成腹を行い、全体の腹厚が約5 4m となるようにした。なか、第2図にかいて、20はターゲットをとりつける鉤板、21はSi₅N₄板で、22はTi板である。23はTi 板をかさえるTi 製のネジ、Ti板22は3つのターゲットを同時にスパッタした混合腹にかいて約5 vol.9以下となるような面积比とした。

このようにして形成した本突施例のサーマルへ
, ドの発熱体部の断面形状を第1図に示す。同図
にかいて、1はアルミナ基板、2はグレーズ層で、
第5図と同一のものである。11はTiC-SiO2
サーメット抵抗体膜、12はCr電極、13はCu 電粒、14かよび15は本発明の突施例による耐 豚毛保護膜で、14はSiC-Si,N4混合耐摩託保 酸膜、15はTiを添加したSiC-Si,N4混合耐 歴紙保験膜である。

本契宛例のサーマルへ,ドの耐原耗保験膜の表面抵抗は $10^6\Omega$ ・ Ω であった。これは、 Tiの添加による効果である。 転写紙を用いて表面をこすり

帝包仕を測定したが、原電気の帝電は校出されな。 かった。

この耐解耗保証額を形成したサーマルへッドを、 医写紙および発色形感熱紙の両方で印字走行試験 を行った。この結果は、両方の場合ともに良好な 結果が待られ、砂電気による破壊も、また電気化 学的反応による関係も生じないことが確認された。 この時の縁耗量はTi を添加しない場合と特に差 途はなく、30加以上の走行弱命を保証できた。

また、本突施例で作成したサーマルへッドの耐 熱パルス等性を第3図に示す。同図において、本 突随例の結果を△に示すが、従来の作成方式によ る結果B(特別昭69−111871号公報にも とづくヘッド)に比べてやや良好な結果が得られ、 本発明は耐熱パルス等性についても改容された。 〈突施例2〉

なかった。さらに、摺跡による機械的な曖耗も従来の耐燥耗保設腹(特開昭 69-111871号 公報)と同程度であった。

本 突 施 例は Cr ターゲットを別に用いて 体加するために 体加丘の制御が容易で、 成膜が簡単である。

なか、前記突施例ではTiまたはCrを添加したが、添加する金瓜はこれらに限定されるものでないことは説明するまでもない。また、前記突施例の抵抗体膜材料や包包材料に限定されるものでないことも説明するまでもない。

発明の効果

本発明は、SIC-Si,N。混合耐寒低保護膜をSIC-Si,N。の混合腔とSIC-Si,N。一金品混合膜の2 配射成とすることにより、発色形成熱紙かよび医写紙のどちらに対しても良好な記録寿命を有するサーマルへ、ドを得られる。このために、ファクシミリや各種カラーブリンタ等への応用が期待できる。

4、図面の簡単を脱明

本実施例のサーマルへ,ドの発展部の断面形状を第4図に示す。同図において、1はアルミナ基板、2はグレーズ心で、第5図と同一のものである。41はSi-Taサーメット抵抗体膜、12はCr 電役、13はCu 包役、14と46は本発明の実施例による財際年保監膜で、14はSiCーSi,N,混合耐解年保監膜、56はCrを添加したSiC-Si,N,混合耐解年保監膜である。

本突施例のサーマルへ、ドも張写紙及び発色形 感熱紙での印字走行試験を行ったが、伊電気によ る破壊も、また冗気化学的反応による遅鈍も生じ

第1図は本発明の第1の突施例による耐解耗保 設度を設けたサーマルへッドの発照体部の断面形 状を示す図、第2図は本発明の第1の突施例でT1 を添加する場合のターゲット 解成を示すもので、 (A)は平面図、(B)は同図(A)の A - A'断面部形状を示す す図、第3図は本発明の第1の突施例にもとの サーマルへッドの母無パルス特性を比較した図、 第4図は本発明の第2の突施例による母腔 取りたサーマルへッドの発照体部の断面形状を示す図、第6図は従来のサーマルへッドの発無 を示す図、第6図は従来のサーマルへッドの発無 体部の断面形状を示す図である。

1 ····・絶級性基板(アルミナ基板)、11,41
····・抵抗体膜(TiC-SiO2サーメット抵抗体膜、
Si-Taサーメット抵抗体膜、12・13····・給

電用導体膜(電粒)、14,16,46····・・

研修に、 SiC-Si,N4混合耐容に膜、Ti 松加

SiC-Si,N4混合耐磨に膜・Cr 松加 SiC-Si,N4

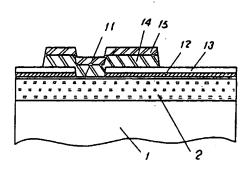
混合耐磨に限)。

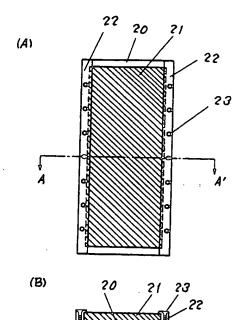
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 2 図

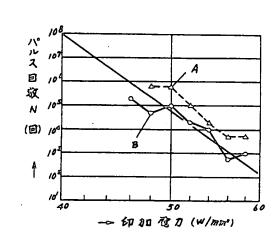
11 ···Tic · Sior サーメート総执外版 12.13··· 仓 極 14···Sic · SioN 4 混合耐冷既取 15···Ti 恐如 Sic · SioN 4 混合耐 号 終 戰

料 1 図

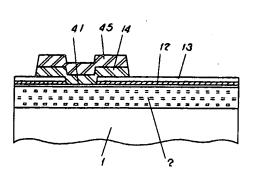




第 3 図



51. 4. R9



郊 5 図

